Magnetic Field Measurement of Fast Electromagnetic Phase Shifter Prototype for a Polarization-Controlled Undulator

I. Ito^{1,A)}, N. Nakamura^{A)}, K. Shinoe^{A)}, T. Shibuya^{A)}, H. Kudo^{A)} H. Takaki^{A)},

T. Tanaka^{B)}, H. Kitamura^{B)}, T. Bizen^{C)}

^{A)} ISSP, University of Tokyo, 5-1-5, Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-8581

^{B)} SPring-8 Center, RIKEN ^{C)} JASRI 1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo, Hyogo 679-5148

Abstract

A 27-m polarization-controlled undulator that consists of four horizontal and four vertical undulator segments and seven phase shifters will be installed and used at SPring-8 as the most highly brilliant soft x-ray source for the material science beamline of the University of Tokyo. We designed and fabricated a phase shifter prototype to satisfy requirements for the phase shifter. The phase shifter prototype consists of three H-type dipole magnets and the yokes are made of 0.1-mm thick permalloy laminations united and insulated by varnish. The phase shifter prototype showed good performance in reproducibility and frequency response. Furthermore, the integrated AC magnetic field of the prototype was measured with a long coil system and could be easily suppressed to below $1G \cdot cm$ by adjusting the coil currents.

偏光制御アンジュレータ用高速電磁石移相器プロトタイプの磁場測定試験

1. はじめに

東京大学では最先端の物質科学用高輝度軟X線 ビームラインをSPring-8に2010年までに建設する予 定で、このビームラインの光源として27mの偏光制 御アンジュレータを採用した^[112]。この偏光制御ア ンジュレータは4台の水平偏光8の字と4台の垂直偏 光8の字のアンジュレータセグメントが交互に配置 され、その間に高速で偏光制御できる電磁石タイプ の移相器が設置される。この移相器によって、水 平・垂直偏光の軟X線だけでなく高速極性切替でき る円偏光軟X線も供給できる。

移相器には、全ての偏光状態に対応できる位相シ フト(最大波長で最大2π以上)が実現できること、 アンジュレータ光の品質劣化や電子軌道の変動を起 こさないような高い再現性と安定性を有すること、 高速偏光切替(10Hz以上)で行えるように優れた周波 数特性を有することなどが要求される。我々は既に 移相器プロトタイプの設計・製作を行い、性能評価 のための磁場測定試験を進めてきた^[3]。本発表では 移相器プロトタイプの磁場測定試験の現状について 報告する。

2. 移相器プロトタイプとDC磁場測定

移相器のプロトタイプは、ヨーク長が1:2:1の3台 のH型の偏向電磁石(順にA,B,Cと呼ぶ)をビーム 進行方向に並べた構造になっている^[3]。図2にその 写真を示す。各電磁石で同一断面形状のヨークが上 下1つずつあり、0.1mm厚積層パーマロイ(PC系Ni-Co,Cu-Fe)で製作されている。コイルは直径2mmの エナメル銅線が300ターン巻かれていて、測定され た電磁石A,B,Cのコイル抵抗は上下2個の合計で、 R_A=R_c=1.15 Ω 、R_B=1.62 Ω 、インダクタンスは L_A=145.6mH、L_B=247.2mH、L_c=146.9mHである。移 相器プロトタイプ用電源はリップルの小さいリニア アンプ方式(5A30V)で、電流リップルとドリフト は、最大電流5Aに対して100ppm以下に抑えられる ように設計されている^[3]。さらに、電源自身の周波 数応答は、1kHzまでの振幅減衰は-3dB、位相遅れは 90度以下になるように設計・調整されている。移相 器1台で3台の電源が使われる(電源1台で電磁石1 台を励磁する)。



図2. 移相器の外観

移相器のDC磁場についてはすでに測定を済ませている。測定はホールプローブと3次元ムーバで構成された3次元磁場測定システムで行った。コイル電流が I_B =1400AT, I_A = I_C =-1170ATの時のz方向磁場分布を図3に示す。z方向磁場分布の最大磁場はプロ

¹ E-mail: isao-maf@issp.u-tokyo.ac.jp

トタイプの中央で約1075Gであり、3次元磁場解析 コードELF/MAGIC⁽⁴⁾による計算結果とよく一致した。 さらにz方向磁場分布による位相シフトは最小光子 エネルギー250eVに対応する放射波長 λ =4.959nmに 対して最大4 π となり、これは偏光制御アンジュ レータにとって十分な値である。加えて、z方向磁 場分布によるバンプ軌道と角度については、計算で はI_B=1400AT,I_A=I_C=-1170ATでバンプ軌道が閉じる ように設定されているのに対して、測定値で得られ たバンプ軌道のズレは0.75 μ m(58.7G・cm)とゼロに 近い値となった。x方向磁場分布はコイル電流が I_B=1400AT,I_A=I_C= -1170ATの時に-8mmから8mmまで の水平方向の範囲内で磁場の一様性は±0.05%内に 保たれた。



3. 励磁曲線と再現性

図4は移相器の偏向電磁石Bの励磁曲線である。 (a)から、励磁曲線はほとんど直線であり、さらに最 大コイル電流1500ATまで飽和していないことがわ かる。励磁曲線の測定では0ATから1500ATまでス キャンし、さらに1500ATから0ATまでスキャンした。 (b)は705ATから710ATまでの励磁曲線を拡大したも のである。(b)にヒステリシス効果がわずかに観測 できるが、同じコイル電流の磁場の差は最大でわず か0.25G程度である。これは積層パーマロイヨーク が超低ヒステリシスのため、移相器プロトタイプが 高い再現性を有していることを示すものである。







4. 周波数特性

図5は、ホールプローブによって測定された偏向 電磁石A中心の周波数特性を示している。ゲインは 500Hzまで1dBの範囲内で一定であり、位相遅れは 10Hzで1度以下、100Hzで10度以下に収まっている。 コイルの巻き数、すなわちインダクタンスを減らせ ば、移相器と電源の共振周波数が上がるので周波数 特性はさらによくなると期待できる。現在、イン ダクタンスの低いコイルに変えて測定を行う準備を しているところである。



5. AC積分磁場測定

高速円偏光切替では移相器はACで励磁させるが、 AC積分磁場を可能な限りゼロにすることが求めら れる。このAC積分磁場の測定はロングコイルシス テムを用いて行われた。これは長いサーチコイルを 用いてコイルを通過する磁束の変化で誘導される電 圧を計測する方法である。図6にロングコイルシス テムのブロック図を示す。ロングコイルは長さ 600mm、幅5.3mmのガラスエポキシ製のボビンに径 0.2mmの銅線を10回巻きにしたものである。移相器 の磁場Bと、ロングコイルの出力Vの関係は以下の (1)(2)(3)式で表される。ロングコイルの出力Vを計 測すればこれら(1)(2)(3)式で移相器の積分磁場を算 出できる。



図6.AC磁場測定システム

$$B(t) = B_0 \cos(2\pi f t + \Delta \phi)$$
(1)

$$V(t) = V_0 \sin(2\pi f t + \Delta \phi)$$

$$= -n \frac{d}{dt} (B(t)LW)$$

$$= 2\pi f n L W B_0 \sin(2\pi f t + \Delta \phi)$$
(2)

$$B_0 L = \frac{V_0}{2\pi f n W}$$
(3)

システムの制御部はNational InstrumentsのADボー ド(PXI6133)とDAボード(PXI6733)、コントローラ (PXI8106)で構成されていて、これらはLabVIEWで 作ったプログラムで制御する。制御の手順としては まずDAボードからDC信号またはAC信号を3台の電 源の外部参照信号端子に対してそれぞれ独立に入力 する。電源は送られてきた参照信号に応じた電流を 移相器のコイルに流す。DAボードは0~1MHzまで の電圧信号を出力可能である。外部参照信号によっ て制御された電流がコイルに流れると移相器は磁場 を発生し、それをロングコイルで計測する。ロング コイルの出力は微弱であることから、低ノイズプリ アンプで増幅する。このプリアンプはゲインが100 になるように設計されている。プリアンプで増幅し たロングコイルの出力はADボードでサンプリング する。ADボードは16bitで、最小±1.25Vのダイナ ミックレンジで計測が可能であり、よって分解能は 2.5V/2¹⁰=40 µ Vである。このADボードと低ノイズア ンプを併用することで40uV/100=0.4 µ Vの分解能を 実現できる。DAボードとADボードのクロックは同 一なので、移相器の電源に同期して励磁された積分 磁場を計測できる。さらにコントローラのOSはリ アルタイムOSであり、割り込みによって制御プロ グラムが中断することはなく、さらにμ秒の時間精

度を保障できる。

図7は測定された移相器プロトタイプの積分磁場 のパワースペクトル密度である。青線はDC電流 $I_A = I_c = 438$ AT、 $I_B = 521.544$ ATで励磁した場合であり、 50Hzとその高調波にリップルを確認できる。赤線は 10HzのAC電流で励磁した場合である。AC電流で励 磁する場合は、コイル電流0ATで磁場が0Gになり、 さらに0ATの時のコイル電流の時間微分が極力小さ くして電源への負担を軽減するように、振幅と同じ オフセットと位相 $\pi/2$ を与えている。

$$I(t) = I_0 \sin(2\pi f t + \pi/2) + I_0$$
(4)

赤線ではリップルの他に10Hz成分とその高調波の磁 場成分が確認できる。AC電流で励磁した測定では、 I_A 、 I_B 、 I_C の値は10Hz成分がもっとも小さくなるよ うに振幅とオフセット両方を調整された。全てのス ペクトルピークは1(G・cm)²/Hz以下に収まっている ことがわかる。



図7. 積分磁場のパワースペクトル密度

図8はパワースペクトル密度から計算した累積変 位である。0から1000Hzの範囲のパワースペクトル 密度の二乗和の平方根を計算した。赤線は10Hzの AC電流で励磁した場合の累積変位である。この累 積変位には10Hzとその高調波、電源のリップルノイ ズが含まれていて、その値は0.86G・cmである。青 線はDC電流で励磁した場合の累積変位である。こ の累積変位には赤線の累積変位に含まれていた成分 のうち、10Hzとその高調波以外の成分が含まれてい て、その値は0.43G・cmである。さらに50Hz間隔の 段差はリップルノイズを表していて、これらの段差 の二乗差の平方根をとることでリップルノイズの値 を見積もることができ、その値は0.40G・cmである。 緑線はACおよびDC電流で励磁した場合の累積変位 の二乗差の平方根を計算したものである。この累積 変位は高調波成分のみを表していて、その値は 0.74G・cmとなる。



以上の累積変位により算出した全成分の総和、および10Hzとその高調波、リップルノイズ、それ以外の各成分の量をまとめた。二乗和の平方根で計算した累積変位は各々の成分が独立で位相がランダムな場合の総計であり、0.86G・cmとなる。一方、パワースペクトル密度の各成分を単純に足し合わせた値の平方根を計算した(以下、単純和と呼ぶ)。単純和は位相が揃ってリップル・高調波成分が最も大きく現れた場合を想定していて、その値は8.5G・cmである。AC磁場の高調波成分やリップルノイズがバンプ軌道を閉じさせない原因となりうるが、二乗和で1G・cm程度、大きく見積もった単純和でも10G・cm以下であり、大きな影響はないと期待できる。

	二乗和	単純和
総和	0.86G • cm	8.5G • cm
高調波	0.74G • cm	4.7G • cm
リップル	0.40G • cm	1.5G • cm
それ以外の成分	0.19G • cm	2.3G • cm

表1.ノイズ成分の総和

7. まとめ

要件に基づいて設計・製作した偏光制御アンジュ

レータ用移相器のプロトタイプのDC磁場測定、励磁曲線、周波数特性の測定を行い、移相器プロトタ イプは優れた磁場の再現性と周波数特性を有してい ることを確認できた。さらにAC積分磁場測定を行 い、10Hzで励磁した場合の積分磁場はおよそ1G・ cm以下まで抑えることができた。今後はAC積分磁 場測定をさらに進めるとともに、磁場の安定性の評 価や他の積層ヨークとの比較等も行い、実機設計の 参考としたい。

参考文献

- [1] 尾嶋正治, 柿崎明人, "東京大学アウトステーション 計画"、放射光20巻6号, p.383 (2007).
- [2] T. Tanaka and H. Kitamura, AIP Conference Proceedings705 (2004) 231.
- [3] N. Nakamura, et al., Proceedings of the 5th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 33rd Linear Accelerator Meeting in Japan, p719-721.
- [4] http://www.elf.co.jp/product/elfmagic.html